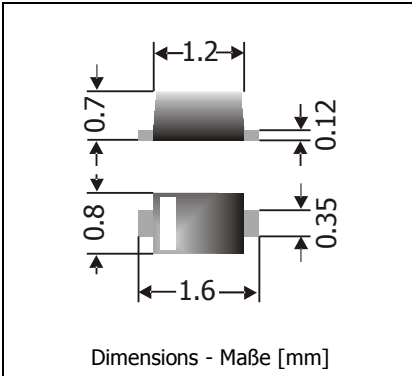


BAS216WT
Fast Switching Surface Mount Si-Planar Diodes
Schnelle Si-Planar-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2010-11-30



Power dissipation – Verlustleistung	150 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	85 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	SOD-523
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



Maximum ratings (T_A = 25°C)

Grenzwerte (T_A = 25°C)

		BAS216WT	
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	150 mW ¹⁾
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)		I _{FAV}	150 mA ¹⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t _p ≤ 1 s t _p ≤ 1 µs	I _{FSM} I _{FSM}	0.5 A 2 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung		V _{RRM}	85 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	-55...+150°C

Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

Forward voltage ²⁾ Durchlass-Spannung ²⁾	I _F = 1 mA I _F = 10 mA I _F = 50 mA I _F = 150 mA	V _F V _F V _F V _F	< 715 mV < 855 mV < 1.0 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	T _j = 25°C V _R = 75 V T _j = 150°C V _R = 25 V T _j = 150°C V _R = 75 V	I _R I _R I _R	< 1 µA < 30 µA < 50 µA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität V _R = 0 V, f = 1 MHz		C _T	1.5 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug I _F = 10 mA über/through I _R = 10 mA bis/to I _R = 1 mA		t _{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 620 K/W ¹⁾

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss
 2 Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%

